

# Транзистор 2Т819

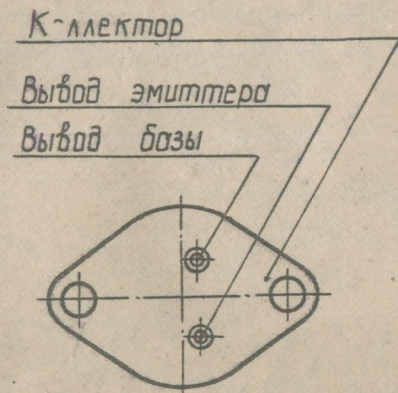


## Э Т И К Е Т К А

Кремниевые меза эпитаксиально - планарные п-р-п транзисторы типов 2Т819А, 2Т819Б, 2Т819В в металлостеклянном корпусе КТ-9 ГОСТ 18472 - 82, предназначенные для работы в линейных и ключевых схемах.

Климатическое исполнение УХЛ

Схема расположения выводов



Этикетка - 2Т819 - 82

Основные электрические параметры

при  $t_{окр} = (25 \pm 10) ^\circ\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения, тип транзистора, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока 2Т819А, 2Т819Б, 2Т819В ( $U_{кб} = 5 \text{ В}$ , $J_3 = 5 \text{ А}$ )	$h_{213}$	20	
Пробивное напряжение коллектор - база, В 2Т819А 2Т819Б 2Т819В ( $J_к = 1 \text{ мА}$ )	$U_{кб0 \text{ проб}}$	100 80 60	
Граничное напряжение, В 2Т819А 2Т819Б 2Т819В ( $J_3 = 100 \text{ мА}$ , $\tau_U \leq 300 \text{ мкс}$ , $Q > 100$ )	$U_{кэ0 гр}$	80 60 40	
Пробивное напряжение эмиттер - база, В 2Т819А, 2Т819Б, 2Т819В ( $J_3 = 5 \text{ мА}$ )	$U_{эб0 \text{ проб}}$	5	
Напряжение насыщения коллектор - эмиттер, В 2Т819А, 2Т819Б, 2Т819В ( $J_к = 5 \text{ А}$ , $J_б = 0,5 \text{ А}$ )	$U_{кэ \text{ нас}}$		1
Напряжение насыщения база - эмиттер, В 2Т819А, 2Т819Б, 2Т819В ( $J_к = 5 \text{ А}$ , $J_б = 0,5 \text{ А}$ )	$U_{бэ \text{ нас}}$		1,5



Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. транзисторов :

золото - 10.0332

серебро { 47.4525

Содержание цветных металлов :

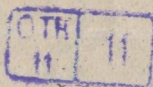
медь - 3,0 г в одном транзисторе

Сведения о приёме

Транзисторы типов 2Т819А, 2Т819Б, 2Т819В соответствуют  
техническим условиям АО.339.142 ТУ.

Приняты по извещению № 304 от 14.12.90

Место для  
штампа ОТК



Место для штампа  
представителя заказчика

Место для штампа \* Перепроверка произведена \_\_\_\_\_ \*

Приняты по извещению № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Место для  
штампа ОТК

Место для штампа  
представителя заказчика